PAT-NO:

JP408137413A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 08137413 A

TITLE:

SEMICONDUTOR LIGHT EMITTING ELEMENT DISPLAY DEVICE

PUBN-DATE:

May 31, 1996

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

ASAKURA, HISAO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD N/A

APPL-NO:

JP06273347

APPL-DATE: November 8, 1994

INT-CL (IPC): G09F009/33, G09G003/32, H01L021/82, H01L033/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the yield of a device by relieving defective LEDs of a semicondutor light emitting element display device by a redundant circuit.

CONSTITUTION: At the time of inspecting an LED display device, all LEDs 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a of pixels 1 are made to emit lights and the inspection of whether LEDs 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a are emitting lights or not is performed by a viewing or a CCD camera, etc., and the fuse F2 of the train of the horizontal direction of the pixels 1 in which LEDs 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a for normal uses and reliefs are emitting is fused by a laser irradiation, etc. In the case LEDs 2, 3, 4, are defective and are not emitting, a fuse 1 is made to be fused by the laser irradiation and then a defective pixels 1 is relieved by selecting the horizontal train of LEDs 2a, 3a, 4a of the pixels 1.

COPYRIGHT: (C)1996, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-137413

(43)公開日 平成8年(1996)5月31日

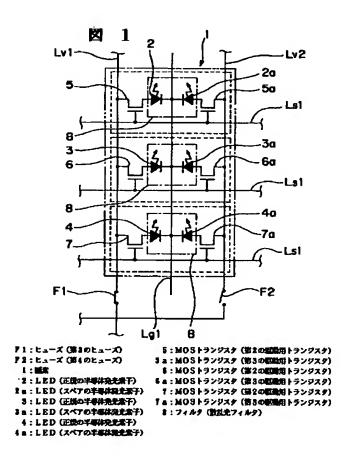
J ₩6273347		H01L 審査請求	21/82 未請求 請求項の数4	R OL (全 9 頁)
F6-273347				
21)出顧番号 特顧平6-273347 22)出顧日 平成6年(1994)11月8日		(71)出願人	000005108 株式会社日立製作所	
8年(1994)11月	8日	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6 番地 (72)発明者 朝倉 久雄 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立 製作所デパイス開発センタ内		
		(74)代理人		<i>71</i> 3
			(74)代理人	(74)代理人 弁理士 筒井 大和

(54) 【発明の名称】 半導体発光素子表示装置

(57)【要約】

【目的】 半導体発光素子表示装置の不良LEDの救済を冗長回路により行い、歩留まりを向上させる。

【構成】 LED表示装置の検査時に、すべての画素1のLED2, 2a, 3, 3a, 4, 4aを発光させ、目視またはCCDカメラなどによりLED2, 2a, 3, 4, 4aが発光しているか否かの検査を行い、正規および救済用のLED2, 2a, 3, 3a, 4, 4aが発光している横方向の画素1の列は、ヒューズF2をレーザ照射などによって溶断させる。LED2, 3, 4が不良により発光していない場合、ヒューズF1をレーザ照射により溶断させ、LED2a, 3a, 4aの横方向の画素1の列を選択し、不良の画素1を救済する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体基板上に半導体素子が形成された モノリシック形の半導体発光素子表示装置であって、半 導体発光素子を救済する冗長回路を設けたことを特徴と する半導体発光素子表示装置。

【請求項2】 前記半導体発光素子表示装置における1 画素が、正規の半導体発光素子と、スペアの半導体発光 素子と、前記正規の半導体発光素子と前記スペアの半導 体発光素子とを駆動する第1の駆動用トランジスタと、 水平走査線におけるすべての前記正規の半導体発光素子 10 に関連する配線を溶断する第1のヒューズと、水平走査 線におけるすべての前記スペアの半導体発光素子に関連 する配線を溶断する第2のヒューズとよりなり、前記正 規の半導体発光素子の内、いずれかの前記正規の半導体 発光素子に不良があると、前記正規の半導体発光素子の 不良に関連する前記第1のヒューズを溶断させ、前記ス ペアの半導体発光素子を発光させることにより、不良の 前記正規の半導体発光素子を救済することを特徴とする 請求項1記載の半導体発光素子表示装置。

【請求項3】 前記半導体発光素子表示装置における1 20 画素が、正規の半導体発光素子と、前記正規の半導体発 光素子を駆動する第2の駆動用トランジスタと、スペア の半導体発光素子と、前記スペアの半導体発光素子を駆 動する第3の駆動用トランジスタと、水平走査線におけ るすべての前記正規の半導体発光素子および前記第2の 駆動用トランジスタに関連する配線を溶断する第3のヒ ューズと、水平走査線におけるすべての前記スペアの半 導体発光素子および前記第3の駆動用トランジスタに関 連する配線を溶断する第4のヒューズとよりなり、前記 正規の半導体発光素子または前記第2の駆動用トランジ 30 スタの内、少なくともいずれかの前記正規の半導体発光 素子または前記第2の駆動用トランジスタに不良がある と、前記正規の半導体発光素子および前記第2の駆動用 トランジスタに関連する前記第2のヒューズを溶断さ せ、前記第3の駆動用トランジスタを駆動および前記ス ペアの半導体発光素子を発光させることによって、不良 の前記正規の半導体発光素子ならびに不良の前記第2の 駆動用トランジスタを救済することを特徴とする請求項 1記載の半導体発光素子表示装置。

【請求項4】 前記正規の半導体発光素子および前記ス 40 ペアの半導体発光素子の上に、前記正規の半導体発光素 子と前記スペアの半導体発光素子との配置における不規 則性から反射により散乱した光の量を減らす散乱光フィ ルタを設けたことを特徴とする請求項1,2または3記 載の半導体発光素子表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体発光素子表示装 置に関し、特に、LED(発光ダイオード)を用いた表 ある。

[0002]

【従来の技術】本発明者が検討したところによれば、こ の種のLEDを用いた表示装置(以下、LED表示装置 という) には、ハイブリッド形とモノリシック形があ 3.

2

【0003】ハイブリッド形は、組立基板上に個々のし EDチップをマトリクス状に配列し、平面表示素子を形 成している。

【0004】また、モノリシック形は、結晶基板上に発 光点をマトリクス状に形成して平面表示素子として用い

【0005】なお、LEDを用いた表示装置について詳 しく記載されている例としては、株式会社昭晃堂発行 「応用光エレクトロニクスハンドブック」1989年4 月10日発行、応用光エレクトロニクスハンドブック編 集委員会(編)があり、この文献には、ハイブリッド形 およびモノリシック形のLED表示装置における構造お よび製造方法などが記載されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところが、上記のよう なLED表示装置では、次のような問題点があることが 本発明者により見い出された。

【0007】すなわち、個々のLEDチップまたは結晶 基板上に発光点をマトリクス状に形成したLED表示装 置では、不良LEDを救済するための冗長回路が設けら れておらず、画素の欠陥などによる歩留まりが生じてし

【0008】本発明の目的は、不良LEDの救済を冗長 回路により行い、歩留まりを向上させる半導体発光素子 表示装置を提供することにある。

【0009】本発明の前記ならびにその他の目的と新規 な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかに なるであろう。

[0010]

【課題を解決するための手段】本願において開示される 発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、 以下のとおりである。

【0011】すなわち、本発明の半導体発光素子表示装 置は、モノリシック形の半導体発光素子表示装置に半導 体発光素子を救済する冗長回路を設けたものである。

【0012】また、本発明の半導体発光素子表示装置 は、1 画素が、正規の半導体発光素子と、スペアの半導 体発光素子と、正規の半導体発光素子とスペアの半導体 発光素子とを駆動する第1の駆動用トランジスタと、水 平走査線におけるすべての正規の半導体発光累子に関連 する配線を溶断する第1のヒューズと、水平走査線にお けるすべてのスペアの半導体発光索子に関連する配線を 溶断する第2のヒューズとよりなり、正規の半導体発光 示装置の冗長回路に適用して有効な技術に関するもので 50 素子の内、いずれかの正規の半導体発光素子に不良があ

ると、正規の半導体発光素子の不良に関連する第1のヒューズを溶断させ、スペアの半導体発光素子を発光させることにより、不良となった正規の半導体発光素子を救済するものである。

【0013】さらに、本発明の半導体発光素子表示装置 は、1 画素が、正規の半導体発光素子と、正規の半導体 発光素子を駆動する第2の駆動用トランジスタと、スペ アの半導体発光素子と、スペアの半導体発光素子を駆動 する第3の駆動用トランジスタと、水平走査線における すべての正規の半導体発光素子および第2の駆動用トラ 10 ンジスタに関連する配線を溶断する第3のヒューズと、 水平走査線におけるすべてのスペアの半導体発光素子お よび第3の駆動用トランジスタに関連する配線を溶断す る第4のヒューズとよりなり、正規の半導体発光素子ま たは第2の駆動用トランジスタの内、少なくともいずれ かの正規の半導体発光素子または第2の駆動用トランジ スタに不良があると、正規の半導体発光素子および第2 の駆動用トランジスタに関連する第2のヒューズを溶断 させ、第3の駆動用トランジスタを駆動およびスペアの 半導体発光素子を発光させることにより不良の正規の半 20 導体発光素子ならびに不良の第2の駆動用トランジスタ を救済するものである。

【0014】また、本発明の半導体発光素子表示装置は、1 画素における正規の半導体発光素子およびスペアの半導体発光素子の上部に、正規の半導体発光素子とスペアの半導体発光素子との配置における不規則性から反射により散乱した光の量を減らす散乱光フィルタを設けたものである。

[0015]

【作用】上記した本発明の半導体発光素子表示装置によ 30 れば、モノリシック形の半導体発光素子表示装置に冗長 回路を設けることにより、不良の半導体素子が存在する 水平走査線を救済することができる。

【0016】また、上記した本発明の半導体発光素子表示装置によれば、1 画素について、スペアの半導体発光素子と、正規の半導体発光素子に関連する配線を溶断する第1のヒューズと、スペアの半導体発光素子に関連する配線を溶断する第2のヒューズを設けることにより、正規の半導体発光素子に不良が発生しても、第1のヒューズを溶断することによりスペアの半導体発光素子を発 40光させ、不良となった正規の半導体発光素子が存在する水平走査線における画素を教済することができる。

【0017】さらに、上記した本発明の半導体発光素子表示装置によれば、1 画素について、スペアの半導体発光素子を駆動する第3の駆動用トランジスタと、水平走査線におけるすべての正規の半導体発光素子および第2の駆動用トランジスタに関連する配線を溶断する第3のヒューズと、水平走査線におけるすべてのスペアの半導体発光素子および第3の駆動用トランジスタに関連する配線を溶断する第4のヒュ

ーズを設けることにより、正規の半導体発光素子または 第2の駆動用トランジスタの内、少なくともいずれかに 不良があっても、第2のヒューズを溶断させ、第3の駆動用トランジスタを駆動およびスペアの半導体発光素子 を発光させることによって、正規の半導体発光素子また は第2の駆動用トランジスタの少なくとも一方に不良が

存在する水平走査線を救済することができる。

【0018】さらに、上記した本発明の半導体発光素子表示装置によれば、1 画素について、1 画素における正規の半導体発光素子およびスペアの半導体発光素子の上部に散乱光フィルタを設けることによって、冗長用の半導体発光素子と正規の半導体発光素子との配置における不規則性から反射により散乱した光の量を減らすことができ、不良の半導体発光素子が存在する水平走査線の暗視部の発生を防止することができる。

[0019]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細 に説明する。

【0020】(実施例1)図1は、本発明の実施例1による救済用のLEDおよびMOSトランジスタが設けられたカラー表示のLED表示装置の要部回路図、図2は、本発明の実施例1によるLED表示装置の1画素当たりの素子レイアウト平面図、図3は本発明の実施例1によるLED表示装置の要部における概略素子断面図である。

【0021】本実施例1において、カラー表示を行うL ED (発光ダイオード)表示装置は、画面を構成する単 位要素である画素1が表示画面に対して横方向および縦 方向に所定の数だけ設けられている。

0 【0022】また、この画素1は、正規のLED(正規 の半導体発光素子)2,3,4およびスペアのLED (スペアの半導体発光素子)2a,3a,4aから構成 されている。

【0023】さらに、LED2, 2aは赤色、LED3, 3aは緑色、LED4, 4aは青色の発光をそれぞれ行い、カラー表示を行うための原色となっている。

【0024】また、画素1には、LED2,3,4を駆動するMOSトランジスタ(第2の駆動用トランジスタ)5,6,7およびLED2a,3a,4aを駆動するMOSトランジスタ(第3の駆動用トランジスタ)5a,6a,7aが設けられている。

【0025】そして、MOSトランジスタ5,6,7のドレインは、ヒューズ (第3のヒューズ) F1を介して電源供給が行われている行選択線Lv1に接続されており、それぞれのソースは、LED2,3,4のアノードと接続されている。

の半導体発光素子および第2の駆動用トランジスタに関 【0026】さらに、MOSトランジスタ5a,6a,連する配線を溶断する第3のヒューズと、水平走査線に 7aのドレインは、ヒューズ(第4のヒューズ)F2をおけるすべてのスペアの半導体発光素子および第3の駆 介して電源供給が行われている行選択線Lv2に接続さ動用トランジスタに関連する配線を溶断する第4のヒュ 50 れており、それぞれのソースは、LED2a,3a,4

aのアノードと接続されている。

[0027] st. LED2, 2a, 3, 3a, 4, 4 aのカソードは、グランド電位に接続されている行選択 線Lg1に接続され、MOSトランジスタ5、5a、 6, 6a, 7, 7aのゲートは、MOSトランジスタ 5, 5a, 6, 6a, 7, 7aをそれぞれ駆動させる列 選択線Ls1に接続されている。

【0028】また、本実施例では、行選択線Lv1, L v2は、MOSトランジスタ5, 5a, 6, 6a, 7, 7aを介してLED2, 2a, 3, 3a, 4, 4aに電 10 源電圧を供給する電源回路 (図示せず) に接続され、そ れぞれの列選択線Ls1は、MOSトランジスタ5,5 a, 6, 6a, 7, 7aを選択して駆動させるドライバ (図示せず) に接続しており、これら電源回路およびド ライバは、CPU (図示せず) によって制御されてい る。

【0029】さらに、LED2、2a、3、3a、4、 4 aの上側には、たとえば、ガラス片を含んだエポキシ 樹脂などからなり、反射により散乱した光の量を減ら し、均一な輝度にするために設計された特性のフィルタ 20 (散乱光フィルタ) 8が成形されたフィルム (図示せ ず)をLED表示画面の表面に貼り付けるようにして設 けられている。

【0030】ここで、本実施例のLED表示装置におけ る画素1の素子レイアウトを図2、図3に示す。

【0031】まず、画素1における素子レイアウトは、 図2に示すように、画素1の中央部にグランド電位に接 続されている行選択線しg1が設けられ、その行選択線 Lg1を挟むように、一方には正規のLED2, 3, 4 が位置しており、他方には、救済用のLED2a、3 a, 4 aが位置している。

【0032】また、LED2, 3, 4の側部には、LE D2, 3, 4を駆動するMOSトランジスタ5, 6, 7 が形成され、反対側のLED2a,3a,4aの側部に は、LED2a、3a、4aを駆動するMOSトランジ スタ5 a, 6 a, 7 aが形成されている。

【0033】さらに、それぞれのMOSトランジスタ 5, 5a, 6, 6a, 7, 7aの近傍には、MOSトラ ンジスタ5, 5a, 6, 6a, 7, 7aに電源供給を行 う行選択線Lv1, Lv2および所定のMOSトランジ 40 スタ5, 5a, 6, 6a, 7, 7aの選択を行う列選択 線Ls 1が配線接続されている。

・【0034】次に、本実施例における画素1のLED 2,2a部分における素子断面を図3に示す。

【0035】まず、サファイアまたは石英などからなる 基板(半導体基板)Tsub上に正規のLED2および 救済用のLED2aが形成され、これらLED2, 2a のカソードはコンタクトConを介してグランド電位に 接続されている行選択線Lg1に接続されている。

【0036】また、LED2, 2aのアノードは、LE 50 【0046】それにより、LED2, 3, 4またはLE

D2, 2aを駆動するMOSトランジスタ5, 5aのソ

ースと接続され、ドレインは電源供給が行われている行 選択線しv1, Lv2と接続している。

【0037】 atc、 choLED2, 2a、 MOSトラ ンジスタ5,5aおよび行選択線Lv1,Lv2などは 絶縁膜Pにより絶縁されている。

【0038】次に、本実施例の作用について説明する。 【0039】LED表示装置の検査時に、LED表示装 置に形成されたすべての画素1のLED2、2a、3、 3a, 4, 4aを発光させ、目視またはCCDカメラな どによりLED2, 2a, 3, 3a, 4, 4aが発光し ているか否かの検査を行う。

【0040】そして、水平走査線、すなわち、LED表 示装置における横方向の画素1の列において、両方のし・ ED2, 2a, 3, 3a, 4, 4aが発光している場合 は、ヒューズF2をレーザ照射などによって溶断を行 い、スペアのLED2a, 3a, 4aに関連する配線を 切断する。

【0041】また、検査時に、たとえば、水平走査線の 内、LED2, 3, 4またはMOSトランジスタ5. 6,7の少なくともいずれかが不良である場合、ヒュー ズF1をレーザ照射などにより溶断させ、LED2, 3,4に関連する配線の切断を行い、LED2a,3 a, 4 aの水平走査線を選択することによって不良の画 素1を救済する。

[0042] 36C, LED2a, 3a, 4ablum OSトランジスタ5a, 6a, 7aを選択することによ り不良の画素1を救済した場合、水平走査線の発光位置 が不規則となり光が反射により散乱してしまうが、この 30 散乱光はフィルタ8により減衰されるので暗視部の発生 を防止できる。

【0043】よって、LED2, 3, 4ならびにMOS トランジスタ5、6、7のどちらか一方または両方に不 良がある場合に、LED2a, 3a, 4aおよびMOS トランジスタ5a, 6a, 7aにより不良の画素1を救 済することができる。

【0044】それにより、本実施例1によれば、不良の LED2, 3, 4またはMOSトランジスタ5, 6, 7 により不良の画素1が発生した場合でも、LED2a, 3a, 4aおよびMOSトランジスタ5a, 6a, 7a により救済でき、効果的にLED表示装置の歩留まりを 向上できる。

【0045】また、本実施例1では、図2に示したよう に、画素1の左側に正規のLED2,3,4を、画素1 の右側に救済用のLED2a, 3a, 4aを位置させた が、図4に示すように、LED2, 2a, 3, 3a, 4,4 aを長方形状に画素1の辺端部近傍まで成形し て、正規のLED2, 3, 4および救済用のLED2 a, 3a, 4aを交互に設けてもよい。

D2a, 3a, 4aのどちらが発光する場合でも発光面 が均一となり、より良好な表示を行うことができる。

【0047】 (実施例2) 図5は、本発明の実施例2に よる救済用のLEDが設けられたモノクローム表示にお けるLED表示装置の要部回路図である。

【0048】本実施例2においては、LED表示装置の 画素1が半導体発光素子であるLED(正規の半導体発 光素子)9、LED(スペアの半導体発光素子)9aお よびLED9、9aを駆動するMOSトランジスタ(第 1の駆動用トランジスタ)10から構成されている。

【0049】また、MOSトランジスタ10のドレイン は、電源供給が行われている行選択線Lv3に接続され ており、ソースは、LED9、9aのアノードと接続さ れている。

【0050】さらに、LED9のカソードは、ヒューズ (第1のヒューズ) F3を介してグランド電位に接続さ れている行選択線Lg2に接続され、LED9aのカソ ードも、ヒューズ (第2のヒューズ) F4を介してグラ ンド電位に接続されている行選択線しg3に接続されて いる。

【0051】また、MOSトランジスタ10のゲート は、MOSトランジスタ10を駆動させる列選択線Ls 2に接続されている。

【0052】さらに、行選択線Lv3は、MOSトラン ジスタ10を介してLED9, 9aに電源電圧を供給す る電源回路 (図示せず) に接続され、列選択線Ls2 は、MOSトランジスタ10を選択して駆動させるドラ イバ (図示せず) に接続しており、これら電源回路およ びドライバは、CPU (図示せず) によって制御されて いる。

【0053】 また、LED9, 9aの上側には、前記実 施例1と同様に、フィルタ(散乱光フィルタ)8が設け られ、フィルタ8が成形されたフィルム (図示せず) を LED表示画面の表面に貼り付けるようにして設ける。 【0054】そして、LED表示装置の検査時に、すべ ての画素1のLED9、9aを発光させ、目視またはC CDカメラなどによりLED9、9aが発光しているか 否かの検査を行い、水平走査線における両方のLED 9, 9aが発光している場合は、ヒューズF4をレーザ 照射などによって溶断を行い、LED9aに関連する配 40 線を切断する。

【0055】また、検査時に水平走査線の内、いずれか のLED9が不良により発光していない場合は、ヒュー ズF3をレーザ照射により溶断させ、LED9aの水平 走査線を選択することによって不良の画素 1を救済す る。

【0056】さらに、正規のLED9と救済用のLED 9aの位置が異なることにより、水平走査線の発光位置 が不規則となり光が反射により散乱してしまうが、この 散乱光はフィルタ8により減衰されるので暗視部の発生 50 射などによって溶断を行い、LED11aに関連する配

を防止できる。

【0057】それにより、本実施例2によれば、不良の LED9が発生した場合でも、LED9aにより画素1 を救済でき、LED9の不良率が大きい傾向にある製造 工程において製造されたLED表示装置の歩留まりを向 上できる。

8

【0058】 (実施例3)図6は、本発明の実施例3に よる救済用のLEDおよびMOSトランジスタが設けら れたモノクローム表示におけるLED表示装置の要部回 10 路図である。

【0059】本実施例3においては、LED表示装置の 画素1の構成は、半導体発光素子であるLED (正規の 半導体発光素子) 11、LED (スペアの半導体発光素 子) 11aおよびLED11, 11aを駆動するMOS トランジスタ (第2の駆動用トランジスタ) 12、MO Sトランジスタ(第3の駆動用トランジスタ)12aか らなっている。

【0060】そして、MOSトランジスタ12のドレイ ンは、ヒューズ (第3のヒューズ) F5を介して電源供 20 給が行われている行選択線Lv4に接続されており、ソ ースは、LED11のアノードと接続されている。

【0061】また、MOSトランジスタ12aのドレイ ンは、ヒューズ (第4のヒューズ) F6を介して電源供 給が行われている行選択線Lv5に接続されており、ソ ースは、LED11aのアノードと接続されている。

【0062】さらに、LED12、12aのカソード は、グランド電位に接続されている行選択線Lg4に接 続され、MOSトランジスタ12, 12aのゲートは、 MOSトランジスタ12、12aを駆動させる列選択線 30 Ls 3に接続されている。

【0063】また、本実施例でも、行選択線Lv4,L v5は、MOSトランジスタ12,12aを介してLE D11, 11aに電源電圧を供給する電源回路 (図示せ ず)に接続され、それぞれの列選択線Ls3は、MOS トランジスタ12、12aを選択して駆動させるドライ バ(図示せず)に接続しており、これら電源回路および ドライバは、CPU(図示せず)によって制御されてい

【0064】さらに、LED11, 11aの上側には、 前記実施例1,2と同様に、フィルタ(散乱光フィル タ)8が設けられ、フィルタ8が成形されたフィルム (図示せず)をLED表示画面1の表面に貼り付けるよ うにして設けられている。

【0065】そして、LED表示装置の検査時に、LE D表示装置におけるすべての画素1のLED11,11 aを発光させ、目視またはCCDカメラなどによりLE D11,11aが発光しているか否かの検査を行う。

【0066】水平走査線において、両方のLED11, 11aが発光している場合は、ヒューズF6をレーザ照 線を切断する。

【0067】また、検査時に、いずれかのLED11ま たはMOSトランジスタ12が不良により発光していな い場合、ヒューズF5をレーザ照射などにより溶断を行 い、LED11に関連する配線を切断して、LED11 aの水平走査線を選択することによって不良の画素1を 救済する。

【0068】さらに、LED11aを選択することによ り画素 1を救済した場合、水平走査線の発光位置が不規 則となり光が反射により散乱してしまうが、この散乱光 10 はフィルタ8により減衰されるので暗視部の発生を防止 できる。

【0069】よって、LED11ならびにMOSトラン ジスタ12のどちらか一方または両方に不良がある場合 に、LED11aおよびMOSトランジスタ12aによ り不良の画素1を救済することができる。

【0070】それにより、本実施例3によれば、不良の LED11またはMOSトランジスタ12により不良の 画素1が発生した場合でも、冗長回路であるLED11 aおよびMOSトランジスタ12aにより救済でき、効 20 果的にLED表示装置の歩留まりを向上できる。

【0071】以上、本発明者によってなされた発明を実 施例に基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例 に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲 で種々変更可能であることはいうまでもない。

【0072】たとえば、前記実施例1~3では、画素1 の救済による暗視部を発生させないためにフィルタ8を 用いたが、図7に示すように、表面が凹凸状に形成され た、たとえば、ガラスなどからなる基板(散乱光フィル タ) Gsub上にサファイアや石英などからなる基板T 30 subを形成し、前記実施例1における図3と同様に、 画素1を成形することにより基板Gsubの凹凸状の表 面が光を散乱させ、フィルタ8を用いずに暗視部の発生 を防止することもできる。

[0073]

【発明の効果】本願によって開示される発明のうち、代 表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、 以下のとおりである。

【0074】(1)本発明によれば、モノリシック形の 半導体発光素子表示装置に冗長回路を設けることによ り、不良の画素の救済を行える。

【0075】(2)また、本発明では、正規の半導体発 光素子および第2の駆動用トランジスタに不良が発生し ても、それに関連する配線を切断する第2,第4のヒュ ーズを溶断することによって不良画素を確実に救済でき る。

【0076】(3)さらに、本発明においては、上記 (1)、(2)により、画素の欠陥に起因する歩留まり を向上できる。

【0077】(4)また、本発明では、複数の半導体発 50 F1 ヒューズ (第3のヒューズ)

光素子の上に設けた散乱光フィルタにより、不良の画素 を救済したことによる暗視部の発生を防止することがで

10

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1による救済用のLEDおよび MOSトランジスタが設けられたカラー表示のLED表 示装置の要部回路図である。

【図2】本発明の実施例1によるLED表示装置の1画 素当たりの素子レイアウト平面図である。

【図3】本発明の実施例1によるLED表示装置の要部 における概略素子断面図である。

【図4】本発明の他の実施例によるLED表示装置の1 画素当たりの素子レイアウト平面図である。

【図5】本発明の実施例2による救済用のLEDが設け られたモノクローム表示におけるLED表示装置の要部 回路図である。

【図6】本発明の実施例3による救済用のLEDおよび MOSトランジスタが設けられたモノクローム表示にお けるLED表示装置の要部回路図である。

【図7】本発明のさらに他の実施例によるLED表示装 置の要部における概略素子断面図である。

【符号の説明】

- 1 画素
- 2 LED (正規の半導体発光素子)
- 2a LED (スペアの半導体発光素子)
- 3 LED (正規の半導体発光素子)
- 3a LED (スペアの半導体発光素子)
- 4 LED (正規の半導体発光素子)
- 4a LED(スペアの半導体発光素子)
- 5 MOSトランジスタ (第2の駆動用トランジスタ) 5a MOSトランジスタ (第3の駆動用トランジス 夕)
 - 6 MOSトランジスタ (第2の駆動用トランジスタ) 6a MOSトランジスタ (第3の駆動用トランジス 夕)
 - 7 MOSトランジスタ (第2の駆動用トランジスタ) 7a MOSトランジスタ (第3の駆動用トランジス 9)
- 8 フィルタ(散乱光フィルタ)
- 40 9 LED (正規の半導体発光素子)
 - 9a LED (スペアの半導体発光素子)
 - 10 MOSトランジスタ (第1の駆動用トランジス 夕)
 - 11 LED (正規の半導体発光素子)
 - 11a LED (スペアの半導体発光素子)
 - 12 MOSトランジスタ(第2の駆動用トランジス 夕)
 - 12a MOSトランジスタ (第3の駆動用トランジス 9)

2a

11

F2 ヒューズ (第4のヒューズ)

F3 ヒューズ (第1のヒューズ)

F4 ヒューズ (第2のヒューズ)

F5 ヒューズ (第3のヒューズ)

F6 ヒューズ (第4のヒューズ)

Lv1~Lv5 行選択線

12

Lg1~Lg4 行選択線

Ls1~Ls3 列選択線

Lv1

Tsub 基板(半導体基板)

Gsub 基板(散乱光フィルタ)

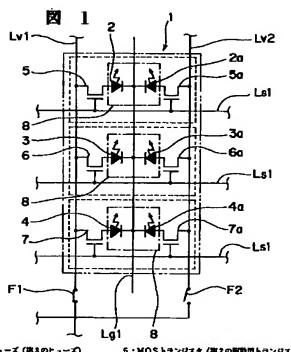
Con コンタクト

P 絶縁膜

【図1】

【図2】

図 2



FL:ヒューズ (第8のヒューズ)

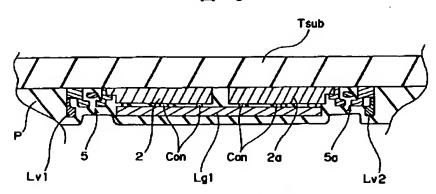
・2:LBD (正規の準導体発光素子) 28:LBD (スペアの半導体発光素子)

1:MOSトランジスク (第2の配動用トランジスタ) 7a:MOSトランジスタ (第3の配動用トランジスタ) 3:LBD (正型の半導体発光素子)
3a:LBD (スペアの半導体発光素子)
4:LBD (正型の半導体発光素子) 8:フィルタ(散型光フィルタ) 4 a:LED (スペアの半導体発光素子)

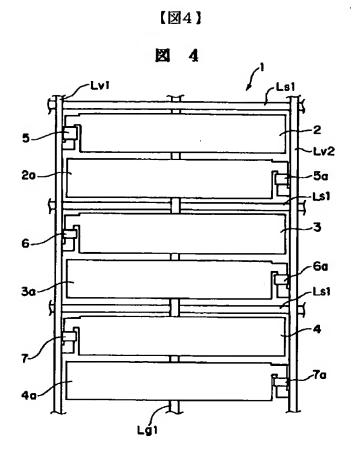
5:MOSトランジスタ(第2の駅助用トランジスタ) 5a:MOSトランジスタ(第3の駅助用トランジスタ) 6:MOSトランジスタ(第2の駅助用トランジスタ) 6a:MOSトランジスタ(第2の駅助用トランジスタ)

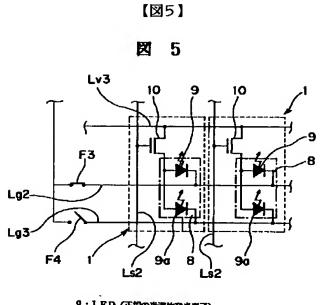
【図3】

図 3



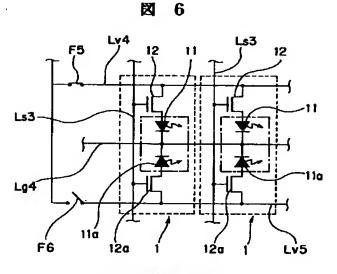
Tsub: 基板 (半導体基板)





9:LED (正規の半導体発光素子) 9a:LBD (スペアの半導体発光素子) 10:MOSトランジスタ (第1の歴動用トランジスタ) F3:ヒューズ (第1のヒューズ) F4:ヒューズ (第2のヒューズ)

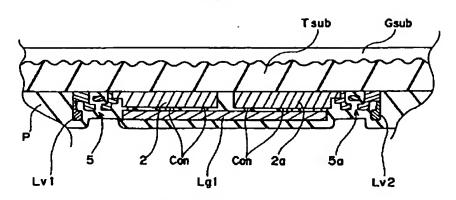
【図6】



- 11:LBD (正規の半導体発光素子)
 11a:LBD (スペアの半導体発光素子)
 12:MOSトランプスタ (第2の配施用トランジスタ)
 12a:MOSトランプスタ (第3の配施用トランジスタ)
 P5:ヒューズ (第3のヒューズ)
 P6:ヒューズ (第4のヒューズ)

【図7】

図 7



Gsub:茲版(改造光フィルタ)